(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



Rec'd PCT/PTO 1 0 DEC 2004

(43) 国際公開日 2003年12月31日(31.12.2003)

(10) 国際公開番号 WO 2004/001510 A1

(51) 国際特許分類7: G03F 7/38, 7/11, H01L 21/027

(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/007354

(22) 国際出願日: 2003年6月10日(10.06.2003)

日本語 (25) 国際出願の言語:

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ: 2002年6月21日(21.06.2002) JP 特願2002-181127

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): クラリ アントインターナショナル リミテッド(CLARIANT INTERNATIONAL LTD.) [CH/CH]; CH-4132 ムッテン ツ 1 ロートハウスシュトラーセ 6 1 Muttenz (CH).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 秋山 靖 (AKIYAMA, Yasushi) [JP/JP]; 〒437-1496 静岡県 小笠 郡大東町 千浜3810 クラリアント ジャパン 株 式会社内 Shizuoka (JP). 高野 祐輔 (TAKANO, Yusuke) [JP/JP]; 〒437-1496 静岡県 小笠郡大東町 千浜 3810 クラリアント ジャパン 株式会社内 Shizuoka (JP). 高橋 清久 (TAKAHASHI, Kiyohisa) [JP/JP]: 〒437-1496 静岡県 小笠郡大東町 千浜 3810 クラリアント ジャパン 株式会社内 Shizuoka (JP). 洪 聖恩 (HONG,Sung-Eun) [KR/JP]; 〒 437-1496 静岡県 小笠郡大東町 千浜3810 クラリ アント ジャパン 株式会社内 Shizuoka (JP). 岡安 哲雄 (OKAYASU, Tetsuo) [JP/JP]; 〒437-1496 静岡県 小笠 郡大東町 千浜3810 クラリアント ジャパン 株式 会社内 Shizuoka (JP).

- (74) 代理人: 鐘尾 宏紀, 外(KANAO,Hiroki et al.); 〒 101-0063 東京都千代田区 神田淡路町2丁目10番 14号 ばんだいビル むつみ国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(国内): CN, KR, SG, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR).

添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PROCESS FOR PREVENTING DEVELOPMENT DEFECT AND COMPOSITION FOR USE IN THE SAME

(54) 発明の名称: 現像欠陥防止プロセスおよびそれに用いる組成物

(57) Abstract: A composition for preventing development defects which contains (1) a salt of a C4-15 perfluoroalkylcarboxylic acid, C4-10 perfluoroalkylsulfonic acid, or perfluoroadipic acid with ammonium, a tetraalkylammonium, or a C1-4 alkanolamine or (2) a salt of an inorganic acid with a quaternary fluoroalkylammonium salt, and in which the acid/base equivalent ratio is from 1/1 to 1/3. This composition is applied to a positive-acting chemical amplification type photoresist film formed on a substrate having a diameter as large as 8 inches or more. Before and/or after application of the composition for preventing development defects, the chemical amplification type photoresist film is baked. This photoresist film is subjected to exposure and post-exposure baking and is then developed. Thus, the decrease in photoresist film thickness through development can be larger by 100 to 600 Å than that in the case where the composition for preventing development defects is not applied. Development defects on substrates having a diameter as large as 8 inches or more are diminished, and resist patterns having a satisfactory sectional shape free from T-top or the like are formed.

(57) 要約: 8インチ以上の大口径基板上に形成されたポジ型化学増幅型フォトレジスト膜上に、酸と塩基の当量 比が $1:1\sim1:3$ として形成された(1) $C_4\sim C_{15}$ のパーフルオロアルキルカルボン酸、 $C_4\sim C_{10}$ のパーフ 😽 ルオロアルキルスルホン酸あるいはパーフルオロアジピン酸のアンモニウム塩、テトラアルキルアンモニウム塩ま たはC₁~C₄のアルカノールアミン塩、または(2)無機酸のフッ素化アルキル4級アンモニウム塩を含む現像欠 陥防止用組成物を塗布し、前記現像欠陥防止用組成物を塗布する前および/または塗布後に化学増幅型フォトレジ スト膜をベークした後、露光、露光後ベークを行い、現像する。これにより、現像欠陥防止用組成物を塗布しない 場合に比べ現像処理後のフォトレジストの膜厚の減少量が、更に100Å~600Å大きくされ、8インチ以上の 大口径基板における現像欠陥が低減されるとともに、T-トップ形状などのない良好な断面形状のレジストパター ンが形成される。



51

				CT/	/JE	Q3,	Ζ0:	200
	200	ATT	TO	_1_	0.1	<u>11-1</u>	<u>.</u>	<u> /UU</u>
er o		71	W					

`		TON	EC 2004		
A. CLASSI	FICATION OF SUBJECT MATTER C1 G03F7/38, 7/11, H01L21/027	Rec'd PCT/P10			
According to	International Patent Classification (IPC) or to both natio	onal classification and IPC			
D EIEI DS	SEARCHED				
Minimum do	cumentation searched (classification system followed by	classification symbols)	ł		
Int.	on searched other than minimum documentation to the e		n the fields searched		
Titon	Chinan Voho 19//-1990	Toroku Jitsuyo Shinan Koho Jitsuyo Shinan Toroku Koho			
Electronic da	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, sear	ch terms used)		
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where appr	ropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
X .	WO 02/29493 Al (Clariant Inte		1,2		
	03 January, 2002 (03.01.02),				
	Full text & JP 2002-6514 A & EP	1306726 Al			
.,	JP 2001-133984 A (Shin-Etsu C	Chemical Co., Ltd.),	1,2		
X	18 May, 2001 (18.05.01),		'		
	Full text (Family: none)				
	JP 2002-148821 A (Shin-Etsu C	Chemical Co., Ltd.),	1,2		
Х	22 May, 2002 (22.05.02),	,			
	Full text				
	(Family: none)				
İ					
į					
× Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
* Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited					
consid	nent defining the general state of the art which is not lered to be of particular relevance	understand the principle or theory un	derlying the invention eannot be		
date	r document but published on or after the international filing	considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered as a second of the consid	dered to involve an inventive		
cited	nent which may throw doubts on priority claim(s) or which is to establish the publication date of another citation or other	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is			
"O" docur	al reason (as specified) nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	combined with one or more other su	ch documents, such on skilled in the art		
mean "P" documents	s ment published prior to the international filing date but later the priority date claimed	"&" document member of the same pater	nt family		
Date of the	e actual completion of the international search September, 2003 (02.09.03)	Date of mailing of the international se 16 September, 2003	arch report 3 (16.09.03)		
1	iling address of the ICA/	Authorized officer			
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		1			
Faccimile	No	Telephone No.			

Facsimile No.

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
Y	US 5631314 A (WAKIYA et al.), 20 May, 1997 (20.05.97), Full text & JP 8-15859 A	1,2
Y	JP 6-148896 A (Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.), 27 May, 1994 (27.05.94), Par. Nos. [0015], [0025] (Family: none)	1,2
A	<pre>JP 5-326389 A (Fujitsu Ltd.), 10 December, 1993 (10.12.93), Full text (Family: none)</pre>	1,2
A	<pre>JP 2000-10294 A (Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.), 14 January, 2000 (14.01.00), Full text (Family: none)</pre>	1,2
A	JP 9-325500 A (Mitsubishi Chemical Corp.), 16 December, 1997 (16.12.97), Full text (Family: none)	1,2